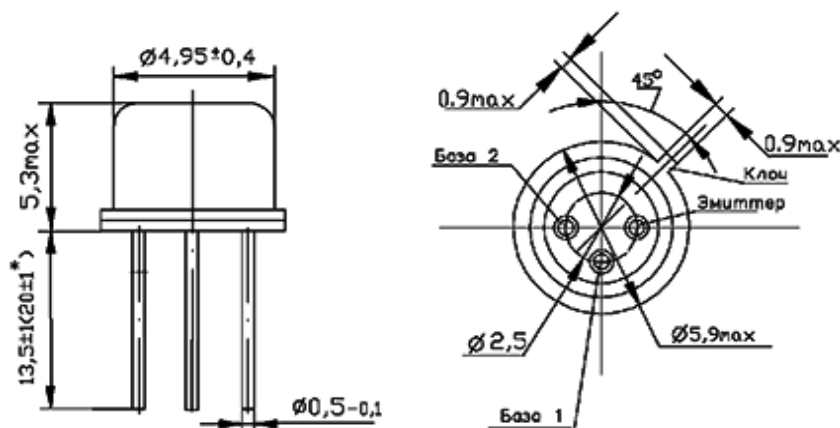


Транзисторы 2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г

Кремниевые планарные однопереходные транзисторы типов 2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г в металлостеклянном корпусе, предназначены для работы в схемах запуска различных электронных устройств аппаратуры специального назначения.

Транзисторы соответствуют техническим условиям ТТЗ.365.000ТУ.



Масса транзистора не более 0,5 г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры транзисторов при приемке и поставке (Т=25°С)

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма	
		не менее	не более
Ток утечки эмиттерного перехода ($U_{ЭБ1} = 30$ В), мкА	$I_{ЭБ0}$	-	1
Коэффициент передачи тока ($U_{Б1Б2} = 10$ В)	η	0,5	0,7
2Т117А		0,65	0,85
2Т117Б		0,5	0,7
2Т117В		0,65	0,85
Межбазовое сопротивление ($I_{Б1Б2} = 1$ мА), кОм	$R_{Б1Б2}$	4	7,5
2Т117А		4	7,5
2Т117Б		6	9
2Т117В		6	9
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($U_{Б1Б2} = 10$ В, $I_Э = 50$ мА)	$U_{БЭ \text{ нас}}$	-	5
Ток включения ($U_{Б1Б2} = 10$ В), мкА	$I_{вкл}$	-	20

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма			
		2Т117А	2Т117Б	2Т117В	2Т117Г
Максимально допустимое постоянное межбазовое напряжение ($R_{ЭБ} = 10$ Ом), В	$U_{Б1Б2 \text{ макс}}$	30	30	30	30
Максимально допустимое обратное напряжение эмиттер-база 2, В	$U_{ЭБ2 \text{ макс}}$	30	30	30	30
Максимально допустимый импульсный ток эмиттера ($U_{ЭБ} = 2$ В), А	$I_{Э \text{ и макс}}$	1	1	1	1
Максимально допустимый постоянный ток эмиттера, мА	$I_Э \text{ макс}$	50	50	50	50
Максимально допустимая постоянная мощность, мВт	$P_{\text{рас макс}}$	300	300	300	300